بیوفیزیک - دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ۸۷/۹/۳۰ - دکتر داستوری

میکروسکوپ الکترونی - لزوم بررسی سلول بعنوان کوچکترین واساسی‌ترین واحد حیات

رابرت هوک اولین مشاهده‌کننده ساختار سلول.

بزرگنمایی صرف کفایت نمی‌کند باید اجزا برای چشم قابل تفکیک باشند.

درشت نمایی یا بزرگنمایی: نسبت اندازه تصویر به اندازه جسم،

میکروسکوپ
- درشتنمایی تجاری: حاصلضرب بزرگنمایی ابژکتیو در اکولر و لوله میکروسکوپ
- درشتنمایی مفید: حاصلضرب شماره ورودی (NA) ابژکتیو در هزار
- درشتنمایی مخصوص: تقسیم 250mm فاصله متوسط رویت واضح با چشم به فاصله کانونی ابژکتیو

تجاری: $GM = G_{ob} \times G_{oc} \times G_T$ ، مفید: $GM = NA \times 1000$

مخصوص: $GM = \frac{250\ mm}{f_{ob}\ mm}$

NA: Numerical Aperature

ابژکتیو (objectice): تقدار عددی ۴، ۸ یا ۱۶ که باهم ترکیب شده‌اند. عمل آن تشکیل اولین تصویر از جسم است که تصویر بزرگتر از جسم، معکوس و حقیقی است.

اکولر: تقداری عدسی محدب است که کار ذره‌بین را انجام می‌دهد. اکولر از تصویر ایجاد شده از ابژکتیو، تصویر مجازی، مستقیم و بزرگ ایجاد می‌کند.

قدرت تفکیک (Resolution): کوچکترین فاصله قابل تشخیص بین دو نقطه واقع بر یک سطح را که بوسیله یک سیستم نوری قابل رویت باشد.

(2)

هر چه مقدار عددی توان تفکیک کمتر باشد، قدرت تشخیص ↑

$$\text{توان تفکیک} = \Sigma = \frac{0.61\lambda}{n\sin\alpha} = \frac{0.61\lambda}{NA}$$ معادله آبه

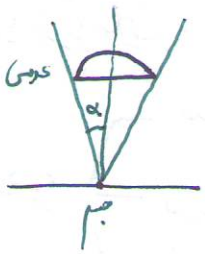
λ: طول موج نور

n: ضریب شکست محیط

0.61: مقدار ثابت

محیط: حد فاصل جسم و اولین عدسی ابژکتیو

α: نیم زاویه مخروط روشنایی، half_angel



روشنایی ↑ ⇐ فاصله ابژکتیو با جسم ↓، مخروط کوتاه‌تر

$2\alpha \longrightarrow 180°$

در حداکثر حالت امکان $\sin\alpha = 1$

راه‌های کم کردن Σ ← کاهش دادن λ (استفاده از طول موج‌های کوتاه) (کاربرد پرتوی دارد)

$n\sin\alpha$ بزرگ گردد ← $0.9 < n\sin\alpha < 1.6$ ✓

+ مقایسه بزرگنمایی و قدرت تفکیک میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی

هر دو رابطه مستقیم با طول موج نور یا پرتو الکترونی دارند نسبت به جسم تابیده می‌شوند.

میکروسکوپ نوری: حداکثر بزرگنمایی ۳۰۰۰ برابر میکروسکوپ الکترونی (TEM): ۲۰۰،۰۰۰ برابر

باید عکس غیر مستقیم تا میلیون برابر

در میکروسکوپ الکترونی: از الکترون‌ها برای تولید تصویر استفاده می‌گردد.

$1A^\circ = 1\times10^{-10}$ meters

طول موج $\lambda = \frac{h}{m\cdot v}$ ← ثابت پلانک 6.63×10^{-34} J.s

سرعت الکترون‌ها حدوداً: ۱۵۰.... km/s (ربع سرعت شهاب (هنده))

جرم الکترون 1.08×10^{-27} m

$\lambda = 0.04\ A^\circ$

(B)

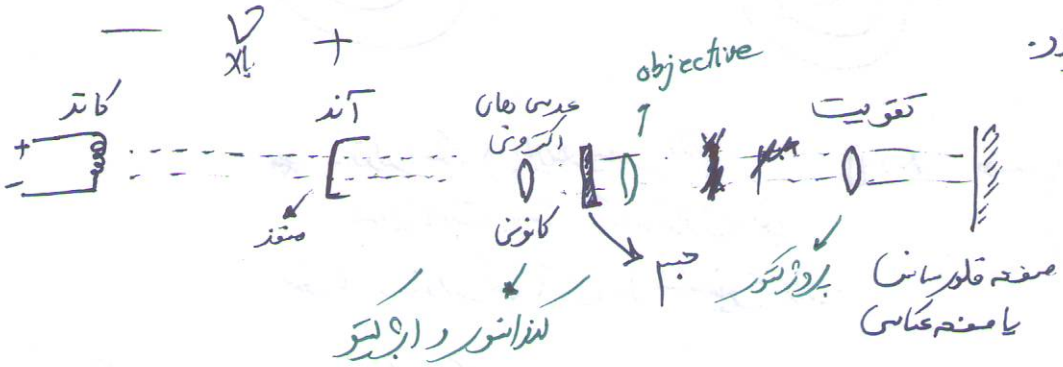
میکروسکوپ الکترونی : در سال 1924 debroglie به کوتاه بودن طول موج پرتوهای الکترونی پس برد. یک سال بعد به این حقیقت رسید که میدان مغناطیسی مناسب پرتوهای الکترونی را در کانون متمرکز می‌کند. (اولین ذهنیت ایجاد میکروسکوپ الکترونی)

Electron Microscope

در E.M منبع پرتوها، رشته‌ای از تنگستن ملتهب شده بوسیله جریان الکتریکی است.

در تهیه ← یک منبع تولید وجود دارد.

داخل لوله میکروسکوپ خلأ ایجاد می‌گردد.



عدسی الکترونی : استفاده از بوبین‌های مغناطیسی دقیق هستند عدسی‌ها هم عمل می‌کنند.

در 1931 میکروسکوپ الکترونی توسط Ruska و Knol ساخته شد.

مهم : نمونه‌ها باید خیلی نازک باشند چون هنگام برخورد الکترونها به مقطع انحراف ایجاد می‌گردد و مغناطیس مقطع باعث تشدید پراکندگی می‌گردد. چون این پراکندگی با انرژی همراه است در ستون میکروسکوپ الکترونها با انرژی کم و در نتیجه طول موج زیاد پدیدار می‌شود و تشکیل تصویر واضح را مختل می‌کند. $< 1000\ A^{\circ}$ ضخامت مواد ارگانیک

مشکل اساسی میکروسکوپهای الکترونی خلأ است که نمی‌توان سلول زنده را مطالعه کرد.

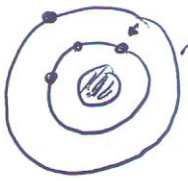
مزیت میکروسکوپ الکترونی به نوری:

۱- عمق میدان زیاد بالا

۲- بزرگنمایی بسیار بالا

۳- توان تفکیک بسیار بالا

کاربرد رایج میکروسکوپ الکترونی ← پرتوی نگار (SEM) ← آنالیز کردن مواد.



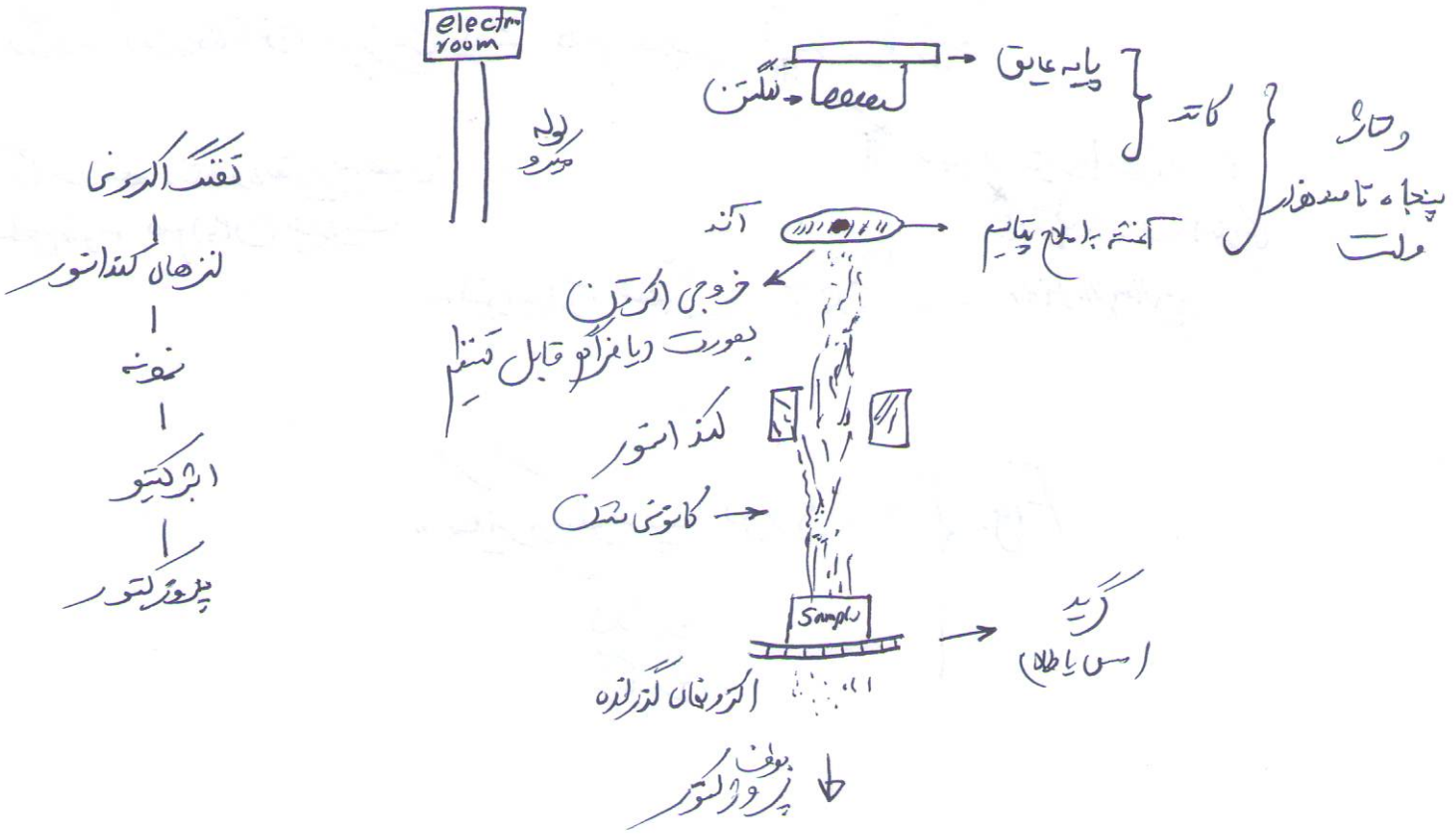
* مقدار انرژی X برای هر عنصر (اتم) مقدار ثابت است که به آن نوع عنصر را تشخیص داد.

← کاربرد دیگر انجام جراحی های میکروسکوپی ← عمل زدن یک سلول مثل خارج کردن هسته و حذف میتوکندری

انواع میکروسکوپ الکترونی:

- میکروسکوپ گذاره Transmission Electron Microscope (TEM)
- میکروسکوپ نگاره Scanning Electron Microscope (SEM)

میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM):



ویژگی صفحه فلورسانس : پلاتینو سیانور باریم

گذاره : الکترونهای گذرنده

یا سولفیدروی

بزرگنمایی میکروسکوپ گذاره : ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ برابری

تولان تفکیک میکروسکوپ گذاره : ۲۰ تا ۴۰ A

دو مشکل عمده این میکروسکوپ

۱- تهیه برش های نازک : که کار طولانی و وقت گیر است

۲- عدم امکان مشاهده نمونه های زنده

میکروسکوپ الکترونی نگاره : SEM

جهت بررسی های ریخت شناختی دقیق، سطح نمونه ها .

تفاوت با گذاره :

در این میکروسکوپ به جای الکترونهای گذرنده از جسم که انرژی زیادی دارند در شکل تصویر از الکترونهای پراکنده از سطح جسم و نیز الکترونهای که در اثر تابش دسته الکترونهای اولیه و تحریک سطح نمونه، از سطح نمونه ها و برتاب میشوند، بنام الکترونهای ثانویه نامیده میشود استفاده میگردد.

تصویر گذاره روی صفحه فلورسانس / تصویر در نگاره ← صفحه تلویزیون

برای مشاهده ساختمان (درونی)

اختلاف پتانسیل شتاب دهنده کمتر از گذاره است. ← قدرت تفکیک ۱۵-۳۰ Å

رنگ‌ها: الکترون‌های ثانویه پراش یافته هم جذب آشکارساز می‌گردد.

① ایجاد نور یا فوتون

③ سیگنال به ولتاژ تبدیل می‌شود

④ Amplifier → ⑤ CRT → ⑥ به شیوه جاروب صفحه

نگاره ← مشاهده تصویر به صورت سطحی نمونه هم امکان پذیر است.

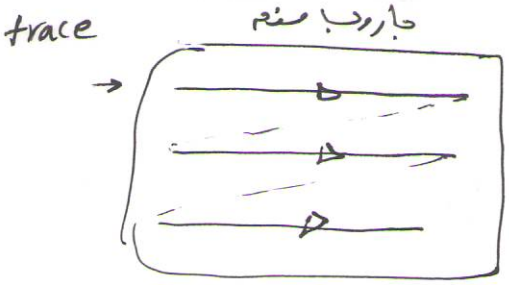
Fig. ۸ « میکروسکوپ نوری

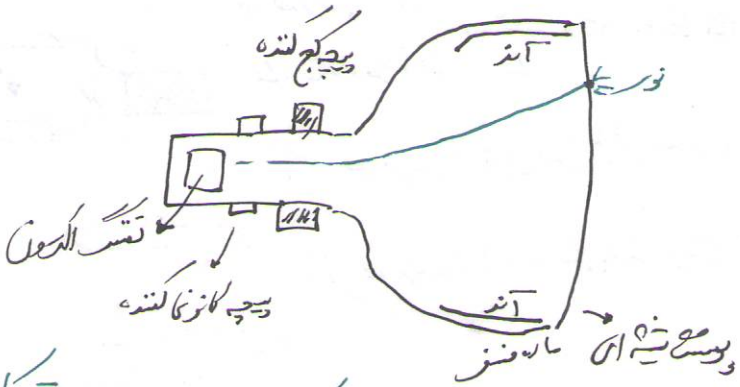
گذاره

نگاره

دستگاه نمایش اسیلوسکوپ یا صفحه تلویزیونی (T.V)

هسته CRT ها (cathod ray tube) است





شدت نور متناسب با شدت الکترونها

تکرار جاروب شدن کل صفحه ۵۰ بار در ثانیه انجام میگیرد.

استاندارد ۵۲۵ رد فعال (trace) است.

عدسی های مغناطیسی

جریان الکترونها در میدان مغناطیسی (میدانهای مغناطیسی) منحرف میگردد.

حوزه مغناطیسی یک سیم پیچ که جریان برق پیوسته از آن میگذرد ایجاد میگردد.

با تغییر جریان ← حوزه مغناطیسی و فاصله کانونی عدسی تغییر میکند. (باید حواسمان به جریان باشد)

فاصله کانونی با سرعت الکترون هم بستگی دارد. (نامتناسب با سرعت)

حرکت ذره باردار در میدانهای مغناطیسی و الکتریکی

ذره‌ای با بار e باربت v در میدان الکتریکی E و مغناطیسی B حرکت میکند.

نیروی وارد بر ذره $F = e.E + ev.B$ (از نیروی گرانش صرفنظر میگردد)

P: اندازه حرکت

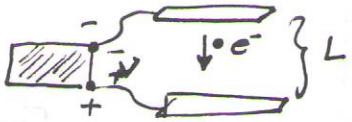
$$\frac{dp}{dt} = eE + evB$$

برای یافتن مکان ذره باید معادله فوق حل شود.

الکترون در میدان الکتریکی :

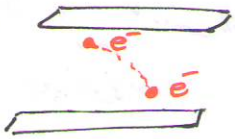
کل نیروی وارد بر ذره باردار حاصل جمع برداری نیروی وارد بر آن از طرف همه بارهای دیگر است

$F = e.E = e.\frac{V}{L}$ V: اختلاف پتانسیل ، L: فاصله دو صفحه



اگر e سرعت اولیه موازی صفحه داشته باشد انحراف ندارد

اگر e سرعت اولیه زاویه دار باشد حرکت سهمی دارد



J (Q.V)

$\frac{1}{2}mv^2 = e.V \Rightarrow v^2 = 2\frac{e}{m}V \xrightarrow{\text{در حالت کلی}} v = 600\sqrt{V}$

↙ انرژی جنبشی — انرژی پتانسیل صفحه

برای مثال در فشار الکتریکی ۱۰۰۰۰ ولت سرعت

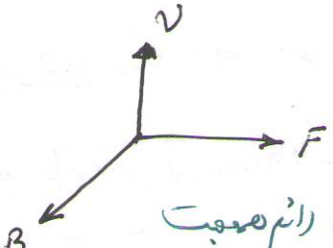
$v = 60000\ km/s$

الکترون در میدان مغناطیسی :

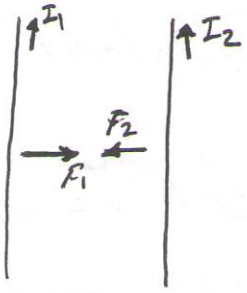
اگر ذره در میدان الکتریکی ذرات باردار متحرک تحت تاثیر نیروی مغناطیسی قرار میگیرند نیروی مغناطیسی

$F = qvB$

همواره عمود بر راستای حرکت ذرات باردار



اگر دست چپ را طوری قرار دهیم که انگشتان از آنها عبور کند نیروی ربایشی و اگر خط‌های دیگر دست چپ با انگشت شست نیروی راننده خواهد بود



$F = B.L.i$

تعداد بار الکتریکی که در ۱ ثانیه طول L را طی کرده اند

$F = B.e.v$

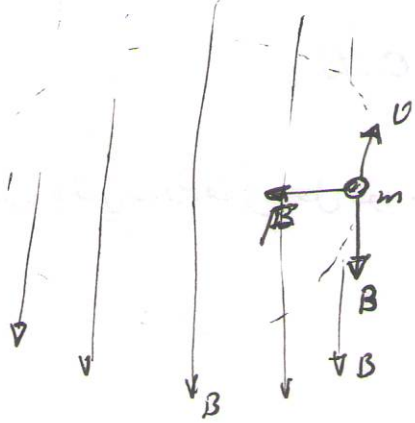
(در مورد ۱ الکترون)

نیروی جانب مرکز

$\frac{mv^2}{R} = Bev$

$\Rightarrow R = \frac{mv}{e.B}$

شعاع دایره



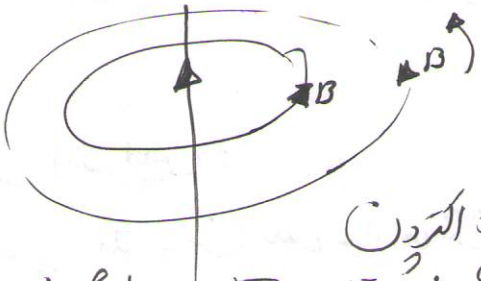
B عمود بر حرکت بوده و از روی ذره را افزایش نمی دهد، سرعت خارج ماندن سیر حرکت مشخص نمی کند.

نکته: در میدان مغناطیسی یکنواخت ذراتی که با سرعت اولیه عمود بر خطوط میدان وارد می‌شوند با سرعت ثابت حرکت می‌کنند.

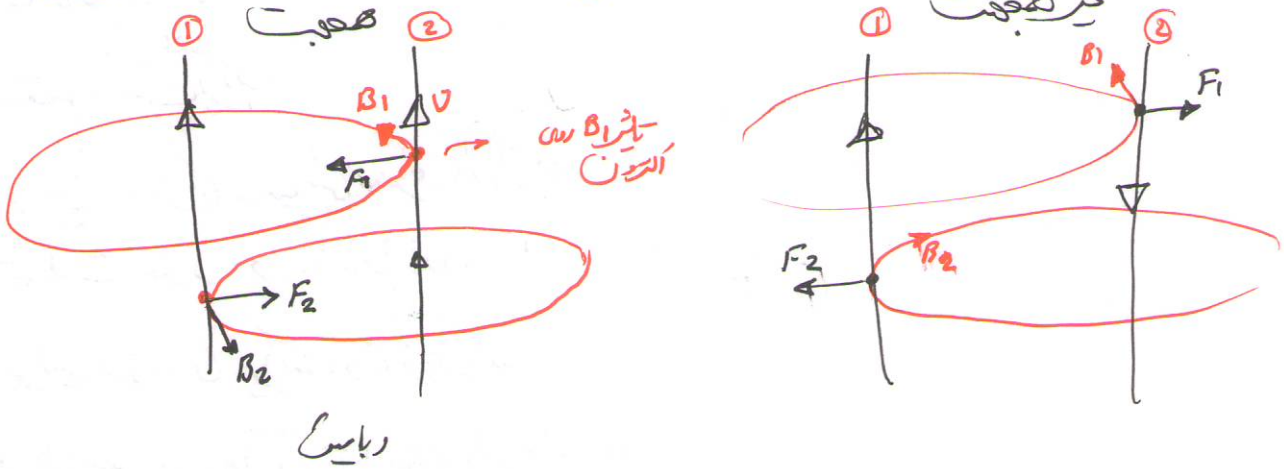
تفرق الکترون X

بررسی تعامل دو سیم موازی دارای جریان:

دو سیم که از آنها جریان می‌گذرد میدان مغناطیسی در نقاط اطراف خود ایجاد می‌کنند.



قانون دست راست: اگر چهار انگشت در جهت حرکت الکترون باشد و میدان مغناطیسی از کف دست خارج گردد انگشت شست جهت نیروی لورنتس را نشان می‌دهد.



ربایش